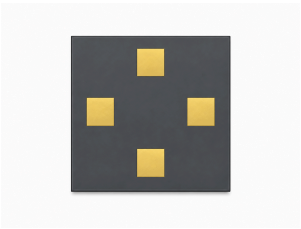
DC–40000 MHz GaAs-RF-Kreuzungsbrückenchip

LCXOV-DC-40000-D — DC–40000 MHz GaAs-RF-Kreuzungsbrückenchip.

Einfügedämpfung: 0.4 dB (typisch); Isolation: 30 dB (typisch);
Rückflussdämpfung: 20 dB (typisch). Chipabmessungen: 0.6 × 0.6 × 0.1 mm.



RF-Kennwerte

TA = +25 °C

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Wert	Einheit
Betriebsfrequenz	-	0	-	40000	DC–40000	MHz
Einfügedämpfung	-	-	0.4	-	-	dB
Isolation	-	-	30	-	-	dB
Rückflussdämpfung	-	-	20	-	-	dB

Grenzwerte

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Einheit
Maximale Eingangsleistung	-	-	-	35	dBm

Umgebungsbedingungen

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Einheit
Lagertemperatur	-	-65	-	150	°C
Betriebstemperatur	-	-55	-	125	°C

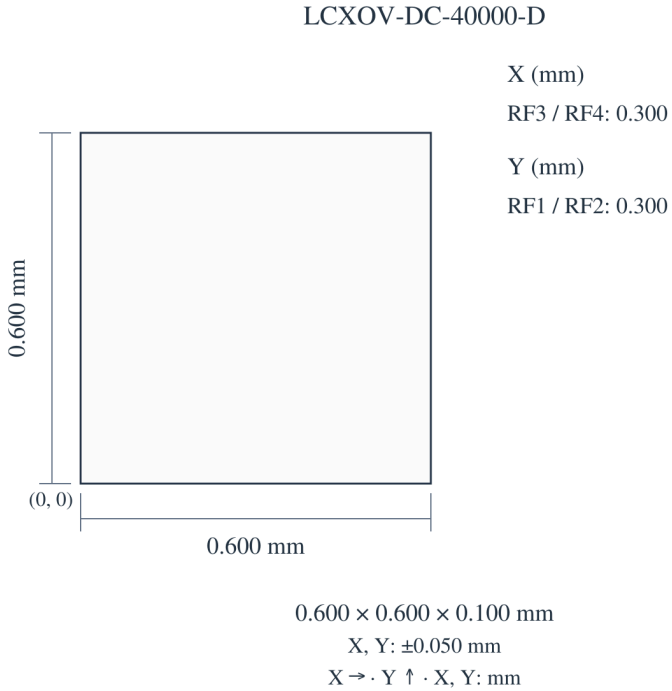
Bondpad-Belegung

Anschlüsse	Symbol	Funktion	Hinweise
RF1	RF1	RF-Anschluss	-
RF2	RF2	RF-Anschluss	-
RF3	RF3	RF-Anschluss	-
RF4	RF4	RF-Anschluss	-

Chipabmessungen

Parameter	Wert	Einheit
Chipabmessungen	0.6 × 0.6 × 0.1	mm

Maßskizze mit ausgewählten Abmessungen in mm. Für Fertigung und Drahtbonden sind vollständige Zeichnungen erforderlich.



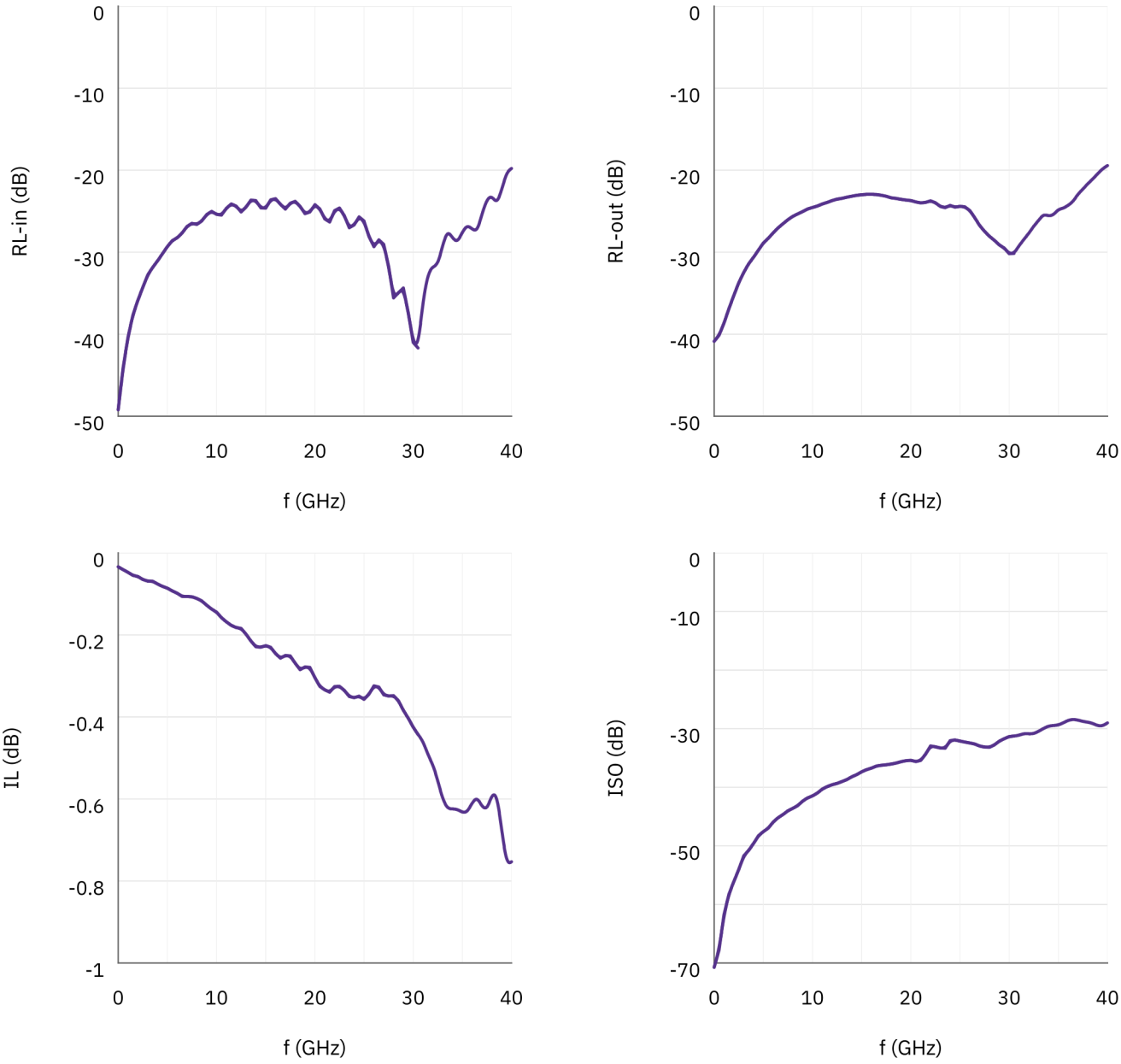
Aktueller Publikationsstand · 1.6 · 2026-11-12. Produktbeschreibung oder redaktionelle Inhalte wurden aktualisiert. Ersetzt Revision 1.5.

Kennlinien

Beachten Sie die bei jeder Abbildung angegebenen Betriebsbedingungen.

Eingangsanpassung; Ausgangsanpassung; Einfügedämpfung; Isolation.

Hinweise zur Abbildung: TA=+25°C. Die ablesbaren Werte sind Näherungswerte. Eingangs- und Ausgangsrückflussdämpfung sowie Isolation sind als vorzeichenbehaftete dB-Werte dargestellt.



Dokumenthinweis

Spezifikationen können revidiert werden. Prüfen Sie vor der Designfreigabe mit LCRF den aktuellen Dokumentstand und die produktspezifischen Anforderungen. Das freigegebene Angebot und die Auftragsunterlagen definieren die gelieferte Konfiguration.